

Übungsblatt 3

Aufgabe 1) Si-Halbleiterprobe

Eine Probe aus Silizium sei n-dotiert mit $n_D = 1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ und befinde sich auf Raumtemperatur $T = 300 \text{ K}$. Die Eigenleitungsträgerdichte beträgt $n_i = 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

- Wie groß ist die Majoritäts- und Minoritätsträgerdichte unter Annahme von Störstellenerschöpfung?
- Nehmen Sie an, dass die Störstellen nicht erschöpft sind und $(W_D - W_F) = 2kT$ gelte. Wie groß ist die Majoritäts- und Minoritätsträgerdichte jetzt?
- Berechnen Sie für den in b) beschriebenen Fall den Abstand des Fermi-niveaus von der Leitungsbandkante. Die effektive Zustandsdichte des Leitungsbandes in Silizium beträgt $N_L = 3,2 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.
- Berechnen Sie für den in c) genannten Fall die Besetzungswahrscheinlichkeit eines Leitungsbandzustandes an der Bandkante. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Besetzungswahrscheinlichkeit eines Donator Zustandes. Erklären Sie warum im Leitungsband signifikante Elektronendichten vorliegen, obwohl dieses energetisch sogar noch über den quasi unbesetzten Donatoren liegt.

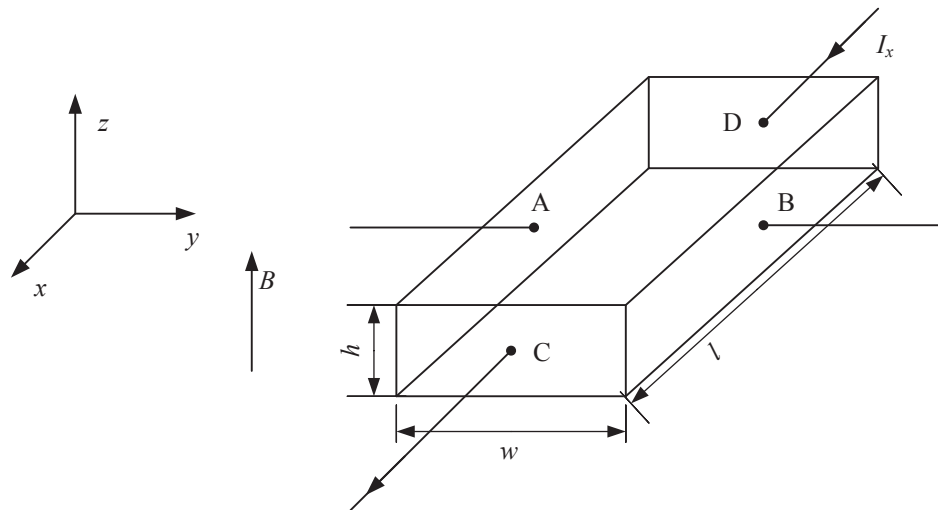
Aufgabe 2) Fermi-Niveau und Trägerverteilung

Es werden die Besetzungswahrscheinlichkeiten für Elektronen im Leitungsband und Löcher im Valenzband von einem Material im thermischen Gleichgewicht betrachtet. Man findet in dem betrachteten Material, dass die Besetzungswahrscheinlichkeit für Elektronen an der Leitungsbandkante gerade gleich groß ist wie die Besetzungswahrscheinlichkeit für Löcher, welche kT unterhalb der Valenzbandkante sind.

- Berechnen Sie die Lage des Fermi-Niveaus relativ zur Mitte der Bandlücke. Gesucht ist ein formaler Ausdruck. Welche zwei Möglichkeiten gibt es für Temperaturen $T > 0 \text{ K}$, die Abweichung des Fermi-niveaus von der Mitte der Bandlücke zu erklären?
- Wenn man die Zustandsdichte und die Besetzungswahrscheinlichkeiten für Elektronen im Leitungsband kennt, kann man die Elektronen-Ladungsträgerverteilung berechnen. Wie weit ist das Maximum der Ladungsträgerverteilung für Elektronen von der Leitungsbandkante entfernt? Gesucht ist ein formaler Ausdruck, gehen Sie davon aus, dass ein nicht entarteter Halbleiter vorliegt und die Boltzmann-Näherung gültig ist.

Aufgabe 3) Hall-Effekt

Gegeben sei ein dotierter Halbleiter mit Breite $w = 2 \text{ mm}$, Höhe $h = 1 \text{ mm}$ und Länge $l = 5 \text{ mm}$. Es liege eine magnetische Flussdichte $B = 40 \text{ mT}$ in z-Richtung an (siehe Skizze) und ein Strom $I_x = 10 \text{ mA}$ fließe der Länge nach in +x-Richtung durch den Halbleiter. Zwischen A und B wird eine Spannung $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 1 \text{ mV}$ gemessen und zwischen D und C eine Spannung $U_{DC} = 500 \text{ mV}$.



- Welche Art der Dotierung liegt im Halbleiter vor?
- Berechnen Sie die Beweglichkeit der Majoritätsträger in dieser Probe. Wie groß ist die Ladungsträgerdichte?
- Erwarten Sie eine Hall Spannung für den Fall eines undotierten Halbleiters, bei dem die Elektronen eine größere Beweglichkeit aufweisen als die Löcher? Begründen Sie Ihre Antwort.